



ADuM3223/ADuM4223

工业逆变器汽车电子

因此, ADuM3223/ADuM4223可以在很宽的正或负切换电压范围内, 可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。



ADI中文版数据手册是英文版数据手册的译文，敬请谅解翻译中可能存在的语言组织或翻译错误，ADI不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。如需确认任何词语的准确性，请参考ADI提供的最新英文版数据手册。

目录

产品特性 1

应用 1

概述 1

功能框图 1

修订历史 2

技术规格 3

 电气特性—5 V电源供电 3

 电气特性—3.3 V电源供电 4

 封装特性 5

 隔离和安全相关特性 5

 法规信息 6

 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10)隔离特性 7

 建议工作条件 8

绝对最大额定值 9

ESD警告 9

引脚配置和功能描述 11

典型性能参数 12

应用信息 15

 PCB布局 15

 传播延迟相关参数 15

 热限制和开关负载特性 15

 输出负载特性 15

 自举半桥操作 16

 直流正确性和磁场抗扰度 16

 功耗 17

 隔离寿命 18

外形尺寸 19

 订购指南 20

 汽车应用级产品 20

修订历史

2014年4月—修订版C至修订版D

更改应用部分 1

更改隔离寿命部分 18

更改“订购指南” 20

2013年12月—修订版B至修订版C

更改特性部分 1

更改表1的开关规格参数 3

表1中增加热关断温度参数 3

更改表2的开关规格参数 4

表2中增加热关断温度参数 4

更改表10 8

更改图13标题 13

更改热限制和开关负载特性部分 15

更改自举半桥操作部分 16

2013年5月—修订版A至修订版B

表10中增加 V_{DDA} 、 V_{DDB} 上升时间：0.5 V/ μ s 8

更改图22 16

2013年1月—修订版0至修订版A

增加汽车应用信息(通篇) 1

更新安全和法规认证(通篇) 1

将高端至低端差分从700 V_{DC PEAK}改为800 V_{peak} 1

表1中增加 R_{OA} 、 R_{OB} 最小和最大值 3

表2中增加 R_{OA} 、 R_{OB} 最小和最大值 4

更改表13 10

更改图19 15

增加自举半桥操作部分和图22；重新排序 16

更改“订购指南” 20

2012年5月—修订版0：初始版

技术规格

电气特性——5 V电源

所有电压均参照其各自的地。除非另有说明， $4.5\text{ V} \leq V_{DD1} \leq 5.5\text{ V}$ ， $4.5\text{ V} \leq V_{DD2} \leq 18\text{ V}$ 。所有最小值/最大值规格适用于 $T_j = -40^\circ\text{C}$ 到 125°C 。所有典型值规格在 $T_j = 25^\circ\text{C}$ ， $V_{DD1} = 5\text{ V}$ ， $V_{DD2} = 12\text{ V}$ 下测得。开关规格的测试条件为CMOS信号电平。

表1.

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
直流规格						
输入电源电流，静态	$I_{DDI}(Q)$		1.4	2.4	mA	
每个通道的输出电源电流，静态	$I_{DDO}(Q)$		2.3	3.2	mA	
1 MHz时的电源电流						
V_{DD1} 电源电流	$I_{DD1}(Q)$		1.6	2.5	mA	最高1 MHz，空载
V_{DDA}/V_{ddb} 电源电流	$I_{DDA}/I_{ddb}(Q)$		5.6	8.0	mA	最高1 MHz，空载
输入电流	I_{IA}, I_{IB}	−1	+0.01	+1	μA	$0 \leq V_{IA}, V_{IB} \leq V_{DD1}$
逻辑高电平输入阈值	V_{IH}	$0.7 \times V_{DD1}$			V	
逻辑低电平输入阈值	V_{IL}			$0.3 \times V_{DD1}$	V	
逻辑高电平输出电压	V_{OAH}, V_{OBH}	$V_{DD2} - 0.1$	V_{DD2}		V	$I_{Ox} = -20\text{ mA}$, $V_{Ix} = V_{IxH}$
逻辑低电平输出电压	V_{OAL}, V_{OBL}		0.0	0.15	V	$I_{Ox} = +20\text{ mA}$, $V_{Ix} = V_{IxL}$
欠压闭锁， V_{DD2} 供电						
趋正阈值	V_{DD2UV+}		4.1	4.4	V	A级
趋负阈值	V_{DD2UV-}	3.2	3.6		V	A级
迟滞	V_{DD2UVH}		0.5		V	A级
趋正阈值	V_{DD2UV+}		6.9	7.4	V	B级
趋负阈值	V_{DD2UV-}	5.7	6.2		V	B级
迟滞	V_{DD2UVH}		0.7		V	B级
趋正阈值	V_{DD2UV+}		10.5	11.1	V	C级
趋负阈值	V_{DD2UV-}	8.9	9.6		V	C级
迟滞	V_{DD2UVH}		0.9		V	C级
输出短路脉冲电流 ¹	$I_{OA}(SC), I_{OB}(SC)$	2.0	4.0		A	$V_{DD2} = 12\text{ V}$
输出脉冲源电阻	R_{OA}, R_{OB}	0.3	1.1	3.0	Ω	$V_{DD2} = 12\text{ V}$
输出脉冲灌电阻	R_{OA}, R_{OB}	0.3	0.6	3.0	Ω	$V_{DD2} = 12\text{ V}$
热关断温度						
结温关断，上升沿	T_{JR}		150		°C	
结温关断，下降沿	T_{JF}		140		°C	
开关规格						
脉冲宽度 ²	PW	50			ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 12\text{ V}$
最大数据速率 ³		1			MHz	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 12\text{ V}$
传播延迟 ⁴	t_{DHL}, t_{DLH}	31	43	54	ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 12\text{ V}$; 见图20
ADuM3223A/ADuM4223A	t_{DHL}, t_{DLH}	35	47	59	ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 4.5\text{ V}$; 见图20
传播延迟偏斜 ⁵	t_{PSK}			12	ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 12\text{ V}$; 见图20
通道间匹配 ⁶	t_{PSKCD}		1	5	ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 12\text{ V}$; 见图20
	t_{PSKCD}		1	7	ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 4.5\text{ V}$; 见图20
输出上升/下降时间(10%至90%)	t_R/t_F	6	12	18	ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 12\text{ V}$; 见图20
每个通道的动态输入电源电流	$I_{DDI}(D)$		0.05		mA/Mbps	$V_{DD2} = 12\text{ V}$
每个通道的动态输出电源电流	$I_{DDO}(D)$		1.65		mA/Mbps	$V_{DD2} = 12\text{ V}$
刷新速率	f_r		1.2		Mbps	

¹ 短路持续时间小于1 μs。平均功率必须符合“绝对最大额定值”下所示的限值。

² 最小脉冲宽度指保证额定时序参数的最短脉冲宽度。

³ 最大数据速率指保证额定时序参数的最快数据速率。

⁴ t_{DLH} 传播延迟根据输入上升逻辑高电平阈值 V_{IH} 到 V_{Ox} 信号的输出上升10%电平的时间测得。 t_{DHL} 传播延迟根据输入下降逻辑低电平阈值 V_{IL} 到 V_{Ox} 信号的输出下降90%阈值测得。有关传播延迟参数的波形，参见图20。

⁵ t_{PSK} 指器件在建议工作条件范围内的相同工作温度、电源电压和输出负载下工作时测得的 t_{DLH} 和/或 t_{DHL} 的最差情况偏差。有关传播延迟参数的波形，参见图20。

⁶ 通道间匹配指两个通道间传播延迟之差的绝对值。

ADuM3223/ADuM4223

电气特性——3.3 V电源

所有电压均参照其各自的地。除非另有说明， $3.0\text{ V} \leq V_{DD1} \leq 3.6\text{ V}$ ， $4.5\text{ V} \leq V_{DD2} \leq 18\text{ V}$ 。所有最小值/最大值规格适用于 $T_j = -40^\circ\text{C}$ 到 125°C 。所有典型值规格在 $T_j = 25^\circ\text{C}$ ， $V_{DD1} = 3.3\text{ V}$ ， $V_{DD2} = 12\text{ V}$ 下测得。开关规格的测试条件为CMOS信号电平。

表2.

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
直流规格						
输入电源电流，静态	$I_{DDI(Q)}$		0.87	1.4	mA	
每个通道的输出电源电流，静态	$I_{DDO(Q)}$		2.3	3.2	mA	
1 MHz时的电源电流						
V_{DD1} 电源电流	$I_{DD1(Q)}$		1.1	1.5	mA	最高1 MHz，空载
V_{DDA}/V_{DDB} 电源电流	$I_{DDA}/I_{DDB(Q)}$		5.6	8.0	mA	最高1 MHz，空载
输入电流	I_{IA}, I_{IB}	-10	+0.01	+10	μA	$0 \leq V_{IA}, V_{IB} \leq V_{DD1}$
逻辑高电平输入阈值	V_{IH}	$0.7 \times V_{DD1}$			V	
逻辑低电平输入阈值	V_{IL}			$0.3 \times V_{DD1}$	V	
逻辑高电平输出电压	V_{OAH}, V_{OBH}	$V_{DD2} - 0.1$	V_{DD2}		V	$I_{Ox} = -20\text{ mA}$, $V_{Ix} = V_{IxH}$
逻辑低电平输出电压	V_{OAL}, V_{OBL}		0.0	0.15	V	$I_{Ox} = +20\text{ mA}$, $V_{Ix} = V_{IxL}$
欠压闭锁， V_{DD2} 供电						
趋正阈值	V_{DD2UV+}		4.1	4.4	V	A级
趋负阈值	V_{DD2UV-}	3.2	3.6		V	A级
迟滞	V_{DD2UVH}		0.5		V	A级
趋正阈值	V_{DD2UV+}		6.9	7.4	V	B级
趋负阈值	V_{DD2UV-}	5.7	6.2		V	B级
迟滞	V_{DD2UVH}		0.7		V	B级
趋正阈值	V_{DD2UV+}		10.5	11.1	V	C级
趋负阈值	V_{DD2UV-}	8.9	9.6		V	C级
迟滞	V_{DD2UVH}		0.9		V	C级
输出短路脉冲电流 ¹	$I_{OA(SC)}, I_{OB(SC)}$	2.0	4.0		A	$V_{DD2} = 12\text{ V}$
输出脉冲源电阻	R_{OA}, R_{OB}	0.3	1.1	3.0	Ω	$V_{DD2} = 12\text{ V}$
输出脉冲灌电阻	R_{OA}, R_{OB}	0.3	0.6	3.0	Ω	$V_{DD2} = 12\text{ V}$
热关断温度						
结温关断，上升沿	T_{JR}		150		$^\circ\text{C}$	
结温关断，下降沿	T_{JF}		140		$^\circ\text{C}$	
开关规格						
脉冲宽度 ²	PW	50			ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 12\text{ V}$
最大数据速率 ³		1			MHz	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 12\text{ V}$
传播延迟 ⁴	t_{DHL}, t_{DLH}	35	47	59	ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 12\text{ V}$ ，见图20
ADuM3223A/ADuM4223A	t_{DHL}, t_{DLH}	37	51	65	ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 4.5\text{ V}$ ，见图20
传播延迟偏斜 ⁵	t_{PSK}			12	ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 12\text{ V}$ ，见图20
通道间匹配 ⁶	t_{PSKCD}		1	5	ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 12\text{ V}$ ，见图20
	t_{PSKCD}		1	7	ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 4.5\text{ V}$ ，见图20
输出上升/下降时间(10%至90%)	t_r/t_f	6	12	22	ns	$C_L = 2\text{ nF}$, $V_{DD2} = 12\text{ V}$ ，见图20
每个通道的动态输入电源电流	$I_{DDI(D)}$		0.05		mA/Mbps	$V_{DD2} = 12\text{ V}$
每个通道的动态输出电源电流	$I_{DDO(D)}$		1.65		mA/Mbps	$V_{DD2} = 12\text{ V}$
刷新速率	f_r		1.1		Mbps	

¹ 短路持续时间小于1 μs 。平均功率必须符合“绝对最大额定值”下所示的限值。

² 最小脉冲宽度指保证额定时序参数的最短脉冲宽度。

³ 最大数据速率指保证额定时序参数的最快数据速率。

⁴ t_{DLH} 传播延迟根据输入上升逻辑高电平阈值 V_{IH} 到 V_{Ox} 信号的输出上升10%电平的时间测得。 t_{DHL} 传播延迟根据输入下降逻辑低电平阈值 V_{IL} 到 V_{Ox} 信号的输出下降90%阈值测得。有关传播延迟参数的波形，参见图20。

⁵ t_{PSK} 指器件在建议工作条件范围内的相同工作温度、电源电压和输出负载下工作时测得的 t_{DLH} 和/或 t_{DHL} 的最差情况偏差。有关传播延迟参数的波形，参见图20。

⁶ 通道间匹配指两个通道间传播延迟之差的绝对值。

封装特性
表3.

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
电阻(输入至输出)	R _{I-O}		10 ¹²		Ω	f = 1 MHz
电容(输入至输出)	C _{I-O}		2.0		pF	
输入电容	C _I		4.0		pF	
IC结至环境热阻						
ADuM3223	θ _{JA}		76		°C/W	
ADuM4223	θ _{JA}		45		°C/W	
IC结至外壳热阻						
ADuM3223	θ _{JC}		42		°C/W	
ADuM4223	θ _{JC}		29		°C/W	

隔离和安全相关特性

ADuM3223
表4.

参数	符号	数值	单位	条件
额定电介质隔离电压		3000	V rms	持续1分钟
最小外部气隙(间隙)	L(I01)	4.0 min	mm	测量输入端至输出端，隔空最短距离
最小外部爬电距离	L(I02)	4.0 min	mm	测量输入端至输出端，沿壳体最短距离
最小内部间隙		0.017(最小值)	mm	隔离距离
漏电阻抗(相对漏电指数)	CTI	>400	V	DIN IEC 112/VDE 0303第1部分
隔离组		II		材料组(DIN VDE 0110, 1/89, 表1)

ADuM4223
表5.

参数	符号	数值	单位	条件
额定电介质隔离电压		5000	V rms	持续1分钟
最小外部气隙(间隙)	L(I01)	8.0(最小值)	mm	测量输入端至输出端，隔空最短距离
最小外部爬电距离	L(I02)	7.6 min	mm	测量输入端至输出端，沿壳体最短距离
最小内部间隙		0.017(最小值)	mm	隔离距离
漏电阻抗(相对漏电指数)	CTI	>400	V	DIN IEC 112/VDE 0303第1部分
隔离组		II		材料组(DIN VDE 0110, 1/89, 表1)

ADuM3223/ADuM4223

法规信息

ADuM3223已获得表6所列机构的认可。

表6.

UL	CSA	VDE
UL 1577 器件认可程序认可 ¹ 单一保护3,000 V均方根值 隔离电压 文件E214100	CSA 元件验收通知#5A批准 基本绝缘符合CSA 60950-1-07和IEC 60950-1标准， 400 V rms (565 V峰值)最大工作电压 文件205078	进行DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10) 认证： 2006-12 ² 加强绝缘， 560 V峰值 文件2471900-4880-0001

¹ 依据UL1577，每个ADuM3223都经过1秒钟绝缘测试电压≥ 3,600 V rms的验证测试(漏电流检测限值为6 µA)。

² 依据DIN V VDE V 0884-10，每个ADuM3223器件都经过1秒钟绝缘测试电压≥1050 V峰值的验证测试(局部放电检测限值为5 pC)。器件标识中的星号(*)表示通过DIN V VDE V 0884-10认证。

ADuM4223已获得表7所列机构的认可。

表7.

UL	CSA	VDE
UL 1577 器件认可程序认可 ¹ 单一保护5,000 V均方根值 隔离电压 文件E214100	CSA 元件验收通知#5A批准 加强绝缘符合CSA 60950-1-07和IEC 60950-1标准， 400 V rms(565 V峰值)最大工作电压；基本绝 缘符合CSA 60950-1-07和IEC 60950-1标准， 800 V rms(1131 V峰值)最大工作电压 文件205078	进行DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10) 认证： 2006-122 加强绝缘， 849 V峰值 文件2471900-4880-0001

¹ 依据UL1577，每个ADuM4223都经过1秒钟绝缘测试电压≥ 6,000 V rms的验证测试(漏电流检测限值为10 µA)。

² 依据DIN V VDE V 0884-10，每个ADuM4223器件都经过1秒钟绝缘测试电压≥1,590 V峰值的验证测试(局部放电检测限值为5 pC)。器件标识中的星号(*)表示通过DIN V VDE V 0884-10认证。

DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10)隔离特性

这些隔离器仅适合安全限制数据范围内的加强隔离。通过保护电路保持安全数据。封装上的星号(*)标志表示通过560 V峰值工作电压的DIN V VDE V 0884-10认证。

表8. ADuM3223 VDE特性

说明	条件	符号	特性	单位
DIN VDE 0110装置分类			I至IV	
额定电源电压≤ 150 V rms			I至III	
额定电源电压≤ 300 V rms			I至II	
额定电源电压≤ 400 V rms			40/105/21	
环境分类			2	
污染度(DIN VDE 0110, 表1)				
最大工作绝缘电压		V_{IORM}	560	V峰值
输入至输出测试电压, 方法B1	$V_{IORM} \times 1.875 = V_{pd(m)}$, 100%生产测试, $t_{ini} = t_m = 1$ 秒, 局部放电 < 5 pC	$V_{pd(m)}$	1050	V峰值
输入至输出测试电压, 方法A	$V_{IORM} \times 1.5 = V_{pd(m)}$, $t_{ini} = 60$ 秒, $t_m = 10$ 秒, 局部放电 < 5 pC	$V_{pd(m)}$		
跟随环境测试, 子类1			896	V峰值
跟随输入和/或安全测试, 子类2和子类3	$V_{IORM} \times 1.2 = V_{pd(m)}$, $t_{ini} = 60$ 秒, $t_m = 10$ 秒, 局部放电 < 5 pC	$V_{pd(m)}$	672	V峰值
最高允许过压		V_{IOTM}	4000	V峰值
浪涌隔离电压	$V_{PEAK} = 10$ kV, 1.2 μ s上升时间, 50 μ s, 50%下降时间	V_{IOSM}	6000	V峰值
安全限值	出现故障时允许的最大值(见图2)			
最高结温		T_S	150	°C
总安全功耗		P_S	1.64	W
T_S 上的绝缘电阻	$V_{IO} = 500$ V	R_S	>10 ⁹	Ω

表9. ADuM4223 VDE特性

说明	条件	符号	特性	单位
DIN VDE 0110装置分类			I至IV	
额定电源电压≤ 150 V rms			I至III	
额定电源电压≤ 300 V rms			I至II	
额定电源电压≤ 400 V rms			40/105/21	
环境分类			2	
污染度(DIN VDE 0110, 表1)				
最大工作绝缘电压		V_{IORM}	849	V峰值
输入至输出测试电压, 方法B1	$V_{IORM} \times 1.875 = V_{pd(m)}$, 100%生产测试, $t_{ini} = t_m = 1$ 秒, 局部放电 < 5 pC	$V_{pd(m)}$	1592	V峰值
输入至输出测试电压, 方法A	$V_{IORM} \times 1.875 = V_{pd(m)}$, 100%生产测试, $t_{ini} = t_m = 1$ 秒, 局部放电 < 5 pC	$V_{pd(m)}$		
跟随环境测试, 子类1			1273	V峰值
跟随输入和/或安全测试, 子类2和子类3	$V_{IORM} \times 1.2 = V_{pd(m)}$, $t_{ini} = 60$ 秒, $t_m = 10$ 秒, 局部放电 < 5 pC	$V_{pd(m)}$	1018	V峰值
最高允许过压		V_{IOTM}	6000	V峰值
浪涌隔离电压	$V_{PEAK} = 10$ kV, 1.2 μ s上升时间, 50 μ s, 50%下降时间	V_{IOSM}	6000	V峰值
安全限值	出现故障时允许的最大值(见图3)			
最高结温		T_S	150	°C
总安全功耗		P_S	2.77	W
T_S 上的绝缘电阻	$V_{IO} = 500$ V	R_S	>10 ⁹	Ω

ADuM3223/ADuM4223

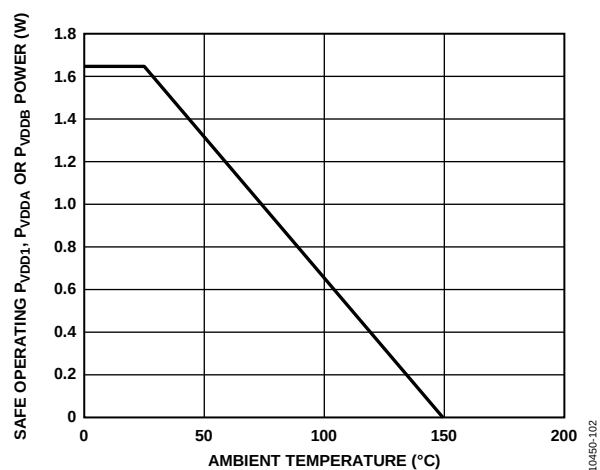


图2. ADuM3223热减额曲线，依据DIN V VDE V 0884-10获得的安全限值与壳温的关系

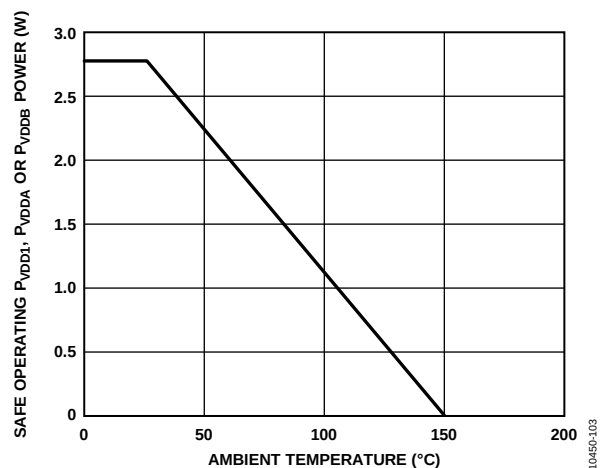


图3. ADuM4223热减额曲线，依据DIN V VDE V 0884-10获得的安全限值与壳温的关系

建议工作条件 表10.

参数	符号	最小值	最大值	单位
工作结温	T_J	-40	+125	°C
电源电压 ¹	V_{DD1}	3.0	5.5	V
	V_{DDA}, V_{ddb}	4.5	18	V
V_{DD1} 上升时间	T_{VDD1}	1		V/μs
V_{DDA} 、 V_{ddb} 上升时间	T_{VDDA}, T_{Vddb}	10		V/μs
输入信号最大上升和下降时间	T_{VIA}, T_{VIB}	1		ms
共模瞬变抗扰度，静态 ²		-50	+50	kV/μs
共模瞬变抗扰度，动态 ³		-25	+25	kV/μs

¹ 所有电压均参照各自的地。有关外部磁场抗扰度的信息，参见“应用信息”部分。

² 静态共模瞬变抗扰度定义为 GND_I 和 GND_A/GND_B 之间的最高 dv/dt 值，其输入保持高电平或低电平，从而使输出电压保持在 $0.8 \times V_{DD2}$ 以上(如果 V_{IA}/V_{IB} = 高电平)，或0.8 V(如果 V_{IA}/V_{IB} = 低电平)。以超出建议水平的瞬态电压工作可能会导致暂时性的数据扰乱。

³ 动态共模瞬变抗扰度定义为 GND_I 和 GND_A/GND_B 之间的最高 dv/dt 值，其开关边沿与瞬变测试脉冲重合。以超出建议水平的瞬态电压工作可能会导致暂时性的数据扰乱。

绝对最大额定值

除非另有说明，环境温度 = 25°C。

表11.

参数	符号	额定值
存储温度	T _{ST}	–55 °C至+150 °C
工作结温	T _J	–40 °C至+150 °C
电源电压 ¹	V _{DD1}	–0.5 V至+7.0 V
	V _{DDA} , V _{DDB}	–0.5 V至+20 V
输入电压 ¹	V _{IA} , V _{IB} , 禁用	–0.5 V至V _{DD1} + 0.5 V
输出电压 ¹	V _{OA}	–0.5 V至V _{DDA} + 0.5 V
	V _{OB}	–0.5 V至V _{DDB} + 0.5 V
每个引脚的平均 输出电流 ²	I _O	–35 mA至+35 mA
共模瞬变 ³	CM _H , CM _L	–100 kV/μs至+100 kV/μs

¹ 所有电压均参照各自的地。

² 不同温度下的最大容许电流参见图2和图3。

³ 指隔离栅上的共模瞬变。超过绝对最大额定值的共模瞬变可能导致闩锁或永久损坏。

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任何其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推断器件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。

ESD警告



ESD(静电放电)敏感器件。
带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管本产品具有专利或专有保护电路，但在遇到高能量ESD时，器件可能会损坏。因此，应当采取适当的ESD防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。

ADuM3223/ADuM4223

表12. 最大连续工作电压¹

参数	最大值	单位	约束条件
交流电压，双极性波形	565	V峰值	最少50年寿命
交流电压，单极性波形	1131	V峰值	最少50年寿命
直流电压	1131	V峰值	最少50年寿命

¹ 指隔离栅上的连续电压幅度。详情见隔离寿命撰部分。

表13. 真值表ADuM3223/ADuM4223(正逻辑)¹

禁用	V _{IA} 输入	V _{IB} 输入	V _{DD1} 状态	V _{DDA} /V _{ddb} 状态	V _{OA} 输出	V _{OB} 输出	注释
L	L	L	有电	有电	L	L	输出在DISABLE = L置位后的1 μs内恢复到输入状态。
L	L	H	有电	有电	L	H	输出在DISABLE = L置位后的1 μs内恢复到输入状态。
L	H	L	有电	有电	H	L	输出在DISABLE = L置位后的1 μs内恢复到输入状态。
L	H	H	有电	有电	H	H	输出在DISABLE = L置位后的1 μs内恢复到输入状态。
H	X	X	有电	有电	L	L	输出在DISABLE = H置位后的3 μs内处于默认低电平状态。
L	L	L	无电	有电	L	L	输出在V _{DD1} 电源恢复后的1 μs内返回到输入状态。
X	X	X	有电	无电	L	L	输出在V _{DDA} /V _{ddb} 电源恢复后的50 μs内恢复到输入状态。

¹ X = 无关，L = 低电平，H = 高电平。

引脚配置和功能描述

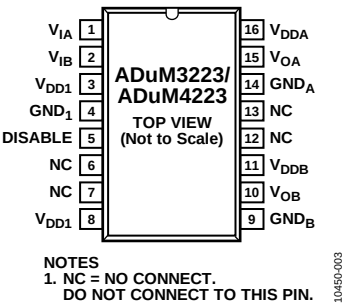


图4. 引脚配置

表14. ADuM3223/ADuM4223引脚功能描述

引脚编号 ¹	引脚名称	说明
1	V _{IA}	逻辑输入A。
6, 7, 12, 13	NC	不连接。
2	V _{IB}	逻辑输入B。
3, 8	V _{DD1}	输入电源电压。
4	GND ₁	输入逻辑信号的接地参考。
5	禁用	输入禁用。禁用隔离器输入，刷新电路。输出在DISABLE = H置位后的3 μs内处于默认低电平状态。输出在DISABLE = L置位后的1 μs内恢复到输入状态。
9	GND _B	输出B的接地参考。
10	V _{OB}	输出B。
11	V _{DDB}	输出B电源电压。
14	GND _A	输出A的接地参考。
15	V _{OA}	输出A。
16	V _{DDA}	输出A电源电压。

¹ 引脚3和引脚8内部互连，并且建议将二者均连接至V_{DD1}。

关于特定布局原则，请参考[AN-1109应用笔记：iCoupler器件的辐射控制建议](#)。

典型性能参数

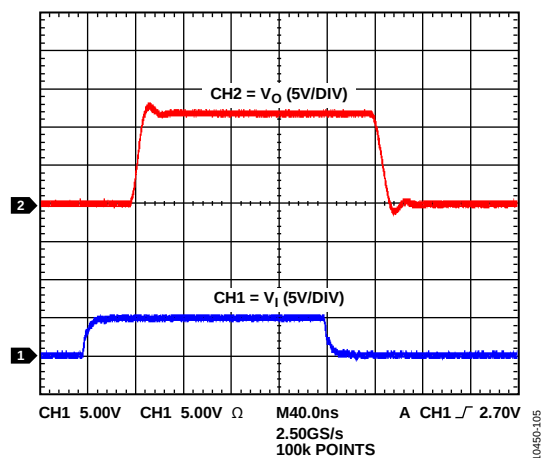


图5. 2 nF负载的输出波形(12 V输出电源)

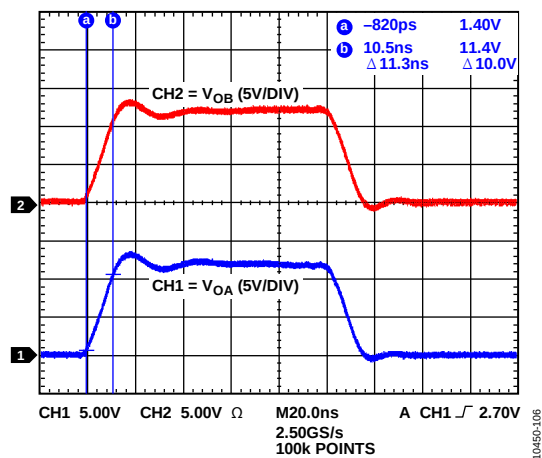


图6. 2 nF负载的输出匹配和上升时间波形(12 V输出电源)

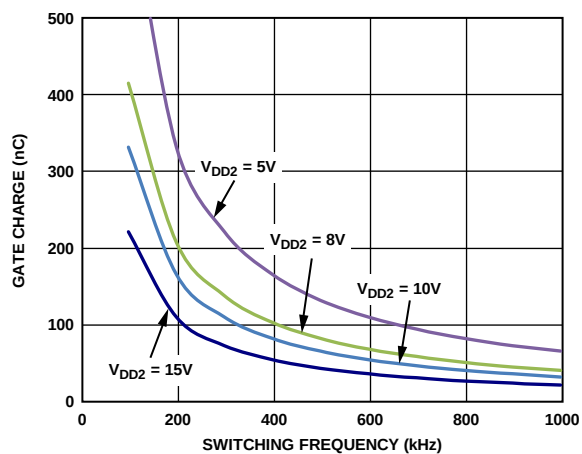


图7. 典型ADuM3223最大负载与频率的关系($R_G = 1 \Omega$)

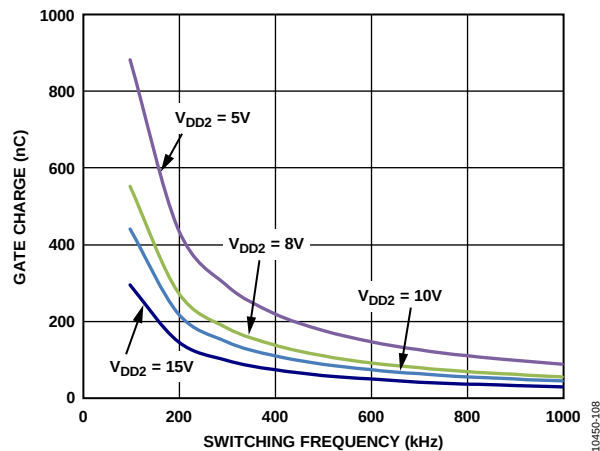


图8. 典型ADuM4223最大负载与频率的关系($R_G = 1 \Omega$)

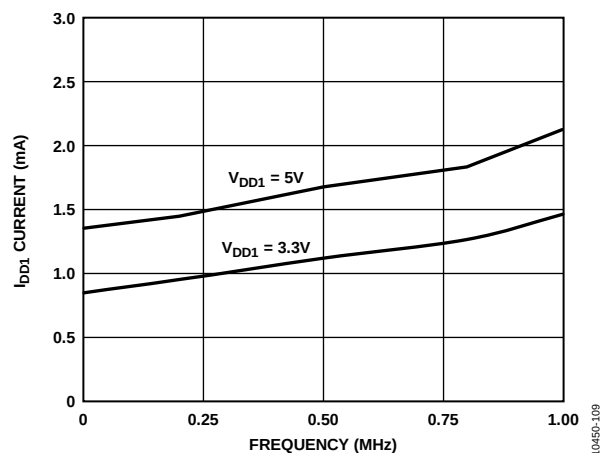


图9. 典型 I_{DD1} 电源电流与频率的关系

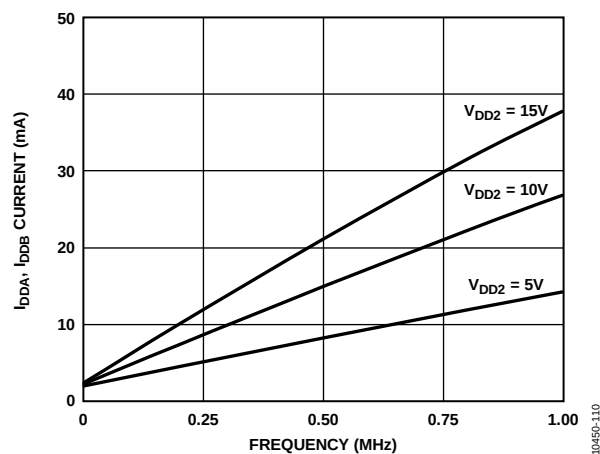


图10. 典型 I_{DDA} 、 I_{DDB} 电源电流与频率的关系(2 nF负载)

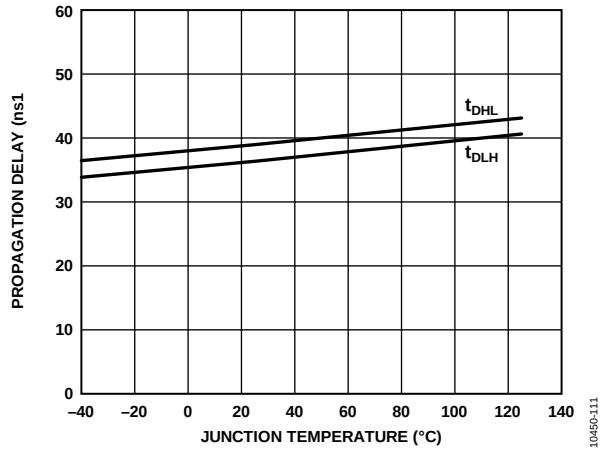


图11. 典型传播延迟与温度的关系

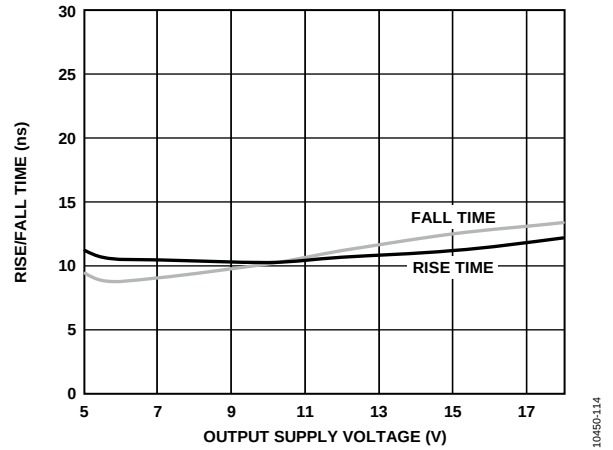


图14. 典型上升/下降时间变化与输出电源电压的关系

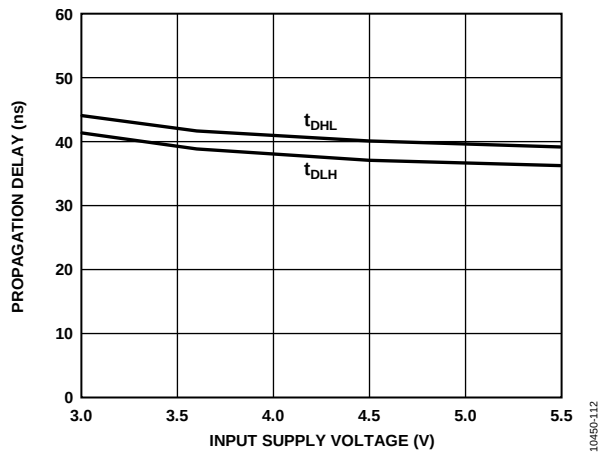


图12. 典型传播延迟与输入电源电压的关系, (V_{DDA} , $V_{DDB} = 12\text{ V}$)

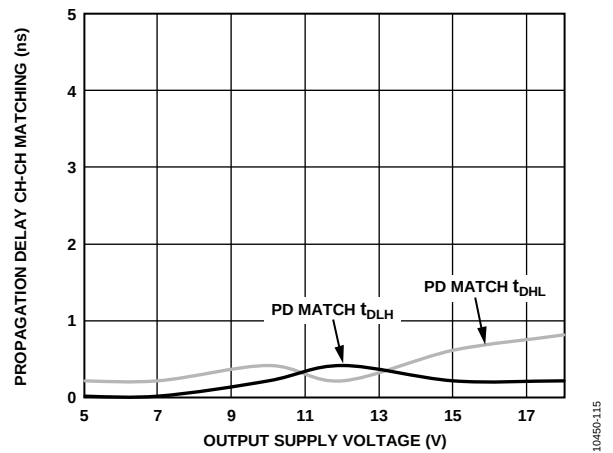


图15. 典型传播延迟通道间匹配与输出电源电压的关系

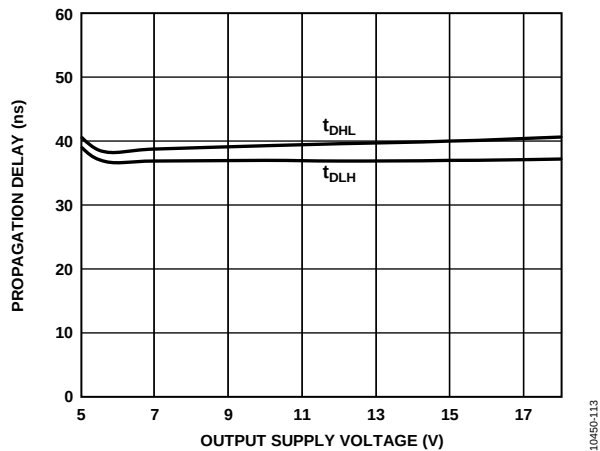


图13. 典型传播延迟与输出电源电压的关系, $V_{DDI} = 5\text{ V}$

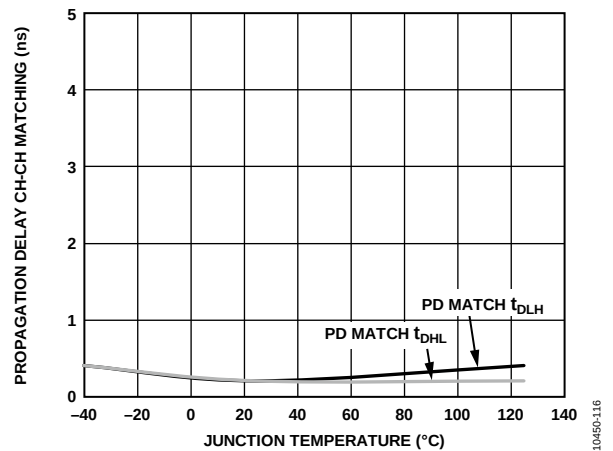


图16. 典型传播延迟通道间匹配与温度的关系, (V_{DDA} , $V_{DDB} = 12\text{ V}$)

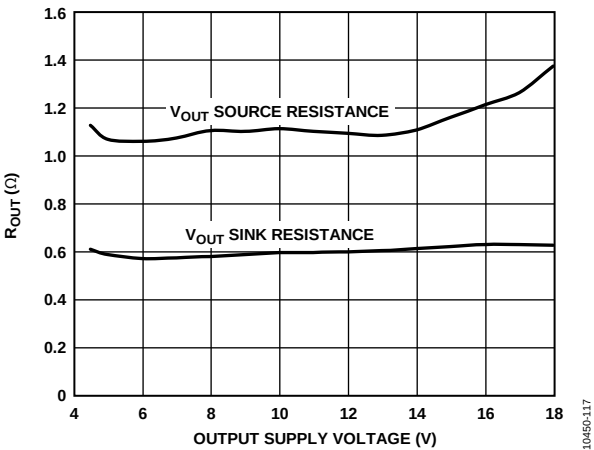


图17. 典型输出电阻与输出电源电压的关系

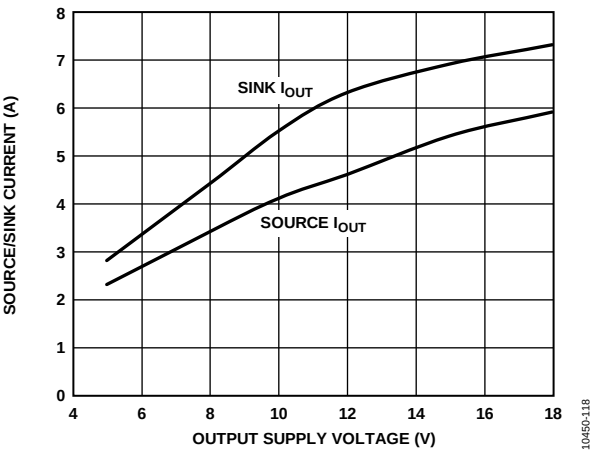


图18. 典型输出电流与输出电源电压的关系

应用信息

PCB布局

ADuM3223/ADuM4223数字隔离器不需要外部接口电路作为逻辑接口。输入和输出供电引脚需要电源旁路，如图19所示。使用电容值在0.01 μF 到0.1 μF 之间的小型陶瓷电容，以提供良好的高频旁路。在输出电源引脚 V_{DDA} 或 V_{DDB} 上，建议再增加一个10 μF 电容，以提供驱动ADuM3223/ADuM4223输出端栅极电容所需的电荷。在输出电源引脚上，应避免使用旁路电容过孔，或者应该使用多个过孔来降低旁路电感值。较小的电容两端到输入或输出电源引脚的走线总长不应超过5 mm。

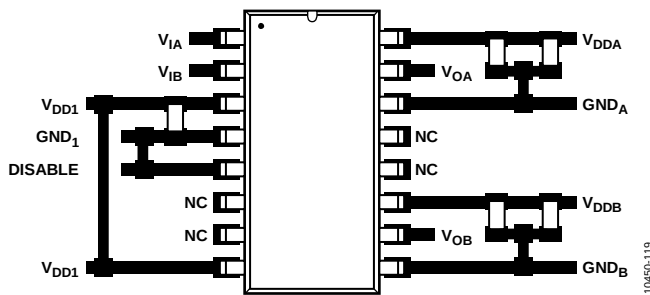


图19. 推荐的PCB布局

传播延迟相关参数

传播延迟是衡量逻辑信号穿过器件所需时间的参数。到逻辑低电平输出的传播延迟可能不同于到逻辑高电平输出的传播延迟。ADuM3223/ADuM4223指定 t_{DLH} (见图20)作为上升输入高电平逻辑阈值 V_{IH} 到输出上升10%阈值之间的时间。同样，下降传播延迟 t_{DHL} 定义为输入下降逻辑低电平阈值 V_{IL} 到输出下降90%阈值之间的时间。上升和下降时间取决于负载条件，并且不包含在传播延迟中，这是栅极驱动器的工业标准。

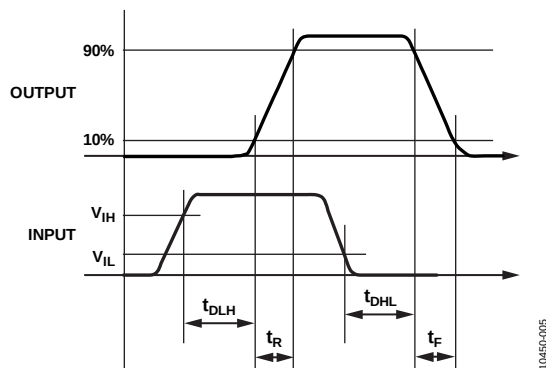


图20. 传播延迟参数

通道间匹配指单个ADuM3223/ADuM4223器件内各通道的传播延迟之间的最大差异。

传播延迟偏斜指在相同条件下工作的多个ADuM3223/ADuM4223器件的传播延迟之间的最大差异。

热限制和开关负载特性

对于隔离式栅极驱动器，在输入和输出电路之间进行必要的隔离可防止在部件下方使用单一散热焊盘。因此主要通过封装引脚来散热。

对于不同输出电压值使用1 Ω 串联栅极电阻能够驱动的最大负载电容，封装散热限制了开关频率与输出负载之间的性能表现，如图7和图8所示。例如，此曲线显示典型的ADuM3223器件可以驱动140 nC栅极电荷、8 V输出(相当于17 nF负载)、最高频率约300 kHz的大型MOSFET。

ADuM3223/ADuM4223隔离器的全部输出均提供热关断保护功能，当上升结温典型值达到150°C时，该功能会将输出设为逻辑低电平，并当结温从关断时的温度下降约10°C时返回原状态。

输出负载特性

ADuM3223/ADuM4223输出信号取决于输出负载(通常是N通道MOSFET)的特性。驱动器输出对于N通道MOSFET负载的响应可以模拟为开关输出电阻(R_{SW})、印刷电路板走线的电感(L_{TRACE})、串联栅极电阻(R_{GATE})和源电容栅极(C_{GS})，如图21所示。

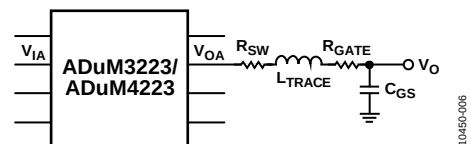


图21. N通道MOSFET栅极的RLC模型

R_{SW} 为内部ADuM3223/ADuM4223驱动器输出的开关电阻，约等于1.1 Ω 。 R_{GATE} 为MOSFET的固有栅极电阻加任意外部串联电阻。需要4 A栅极驱动器的MOSFET，其典型固有栅极电阻约为1 Ω ，栅极-源极电容 C_{GS} 介于2 nF到10 nF之间。 L_{TRACE} 为印刷电路板走线的电感，其典型值为5 nH，或者当采用从ADuM3223/ADuM4223输出端到MOSFET栅极具有短而宽的连接的精心布局，这个值会更小。

给定ADuM3223/ADuM4223接收线圈几何形状及感应电压，解码器最多能够有0.5 V余量的50%，允许的最大磁场见图23所示计算。

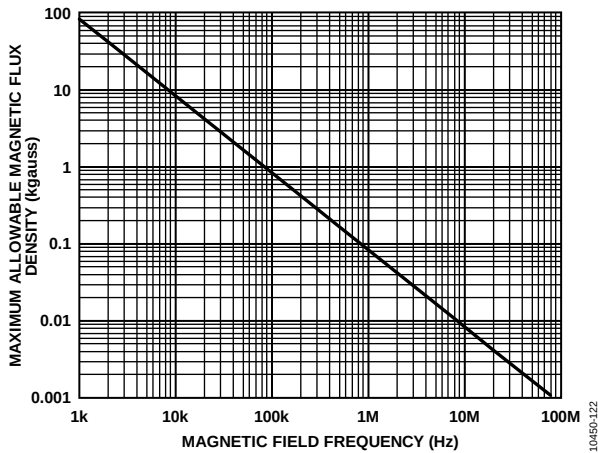


图23. 最大允许外部磁通密度

例如，在1 MHz的磁场频率下，最大允许0.08 K高斯的磁场在接收线圈可以感应出0.251 V的电压。这大约是检测阈值的50%并且不会引起输出转换错误。同样，如果这样的情况在发送脉冲时发生(最差的极性)，这会使接收到的脉冲从大于1.0 V下降到0.75 V，仍然高于解码器检测阈值0.5 V。

先前的磁通密度值对应于与ADuM3223/ADuM4223变压器给定距离的额定电流幅度。图24表明这些允许的电流幅度是频率与所选距离的函数。如图所示，ADuM3223/ADuM4223只有在离器件很近的高频大电流下才会受影响。例如：当工作频率为1 MHz时，0.2 kA电流必须放置在距离ADuM3223/ADuM4223 5 mm以外的地方，才不会影响器件的工作。

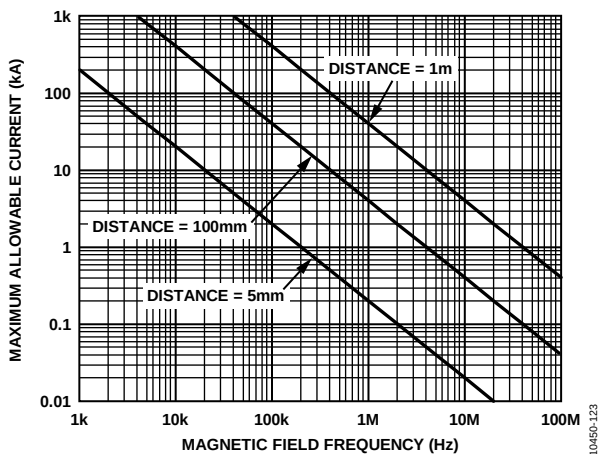


图24. 不同电流至ADuM3223/ADuM4223距离下的最大允许电流

功耗

ADuM3223/ADuM4223隔离器给定通道的电源电流是电源电压、通道数据速率和通道输出负载的函数。

对于每个输入通道，电源电流按照下式计算：

$$IDDI = IDDI(Q) \quad f \leq 0.5fr$$

$$IDDI = IDDI(D) \times (2f - fr) + IDDI(Q) \quad f > 0.5fr$$

对于每个输出通道，电源电流按照下式计算：

$$IDDO = IDDO(Q) \quad f \leq 0.5fr$$

$$IDDO = (IDDO(D) + (0.5) \times CLVDDO) \times (2f - fr) + IDDO(Q) \quad f > 0.5fr$$

其中：

$IDDI(D)$ 、 $IDDO(D)$ 是每个通道的输入和输出动态电源电流(mA/Mbps)。

CL 是输出负载电容(pF)。

$VDDO$ 是输出电源电压(V)。

f 是输入逻辑信号频率(MHz，输入数据速率的一半，NRZ信令)。

fr 是输入级刷新速率(Mbps)。

$IDDI(Q)$ 、 $IDDO(Q)$ 是额定输入和输出静态电源电流(mA)。

为了计算总电源电流，必须计算与IDD1、IDDA和IDDB相对应的各输入和输出通道的电源电流并求和。

图9提供了两个输入通道的总输入IDD1电源电流与数据速率的函数关系。图10提供了两个2 nF电容负载输出端的总IDDA或IDDB电源电流与数据速率的函数关系。

ADuM3223/ADuM4223

隔离寿命

所有的隔离结构在长时间的电压作用下，最终会被破坏。隔离衰减率由施加在隔离层上的电压波形特性决定。除了由监管机构进行测试，ADI也进行一系列广泛的评估来确定ADuM3223/ADuM4223内部隔离架构的寿命。

ADI公司使用超过额定连续工作电压的电压执行加速寿命测试。确定多种工作条件下的加速系数，利用这些系数可以计算实际工作电压下的失效时间。

表12中显示的值总结了双极性交流工作条件下50年工作寿命的峰值电压以及CSA/VDE认可的最大工作电压。许多情况下，认可工作电压高于50年工作寿命电压。某些情况下，在这些高工作电压下工作会导致隔离寿命缩短。

ADuM3223/ADuM4223的隔离寿命由施加在隔离栅上的电压波形决定。*iCoupler*结构的隔离度以不同速率衰减，这由波形是否为双极性交流、单极性交流或直流决定。图25、图26和图27显示这些不同隔离电压的波形。

双极性交流电压环境对于*iCoupler*产品而言是最差的情况，ADI公司推荐的最大工作电压对应的工作寿命为50年。在单极性交流或者直流电压的情况下，隔离应力显然低得多。此工作模式在能够获得50年工作时间的情况下，

允许更高的工作电压。任何与图26和图27中不一致的交叉隔离电压波形都应被认为是双极性交流波形，其峰值电压应限制在表12中列出的50年工作寿命电压以下。

请注意，图26所示的正弦电压波形仅作为示例提供，它代表任何在0 V与某一限值之间变化的电压波形。该限值可以为正值或负值，但电压不能穿过0 V。

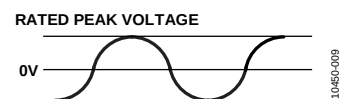


图25. 双极性交流波形

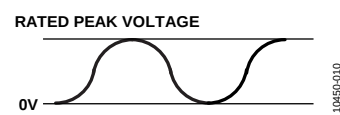


图26. 单极性交流波形

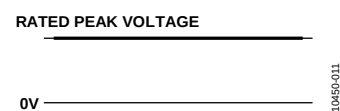
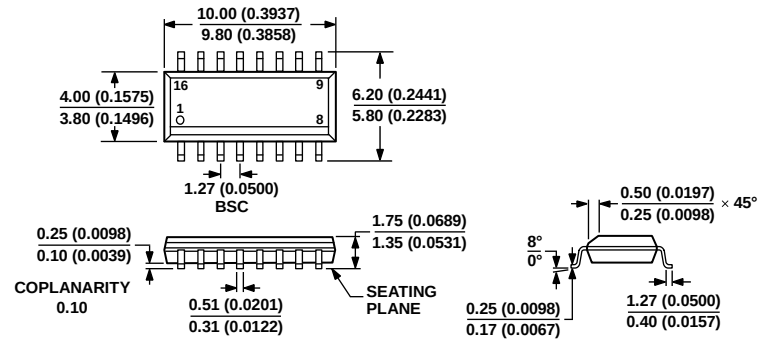


图27. 直流波形

外形尺寸



COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012-AC
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.

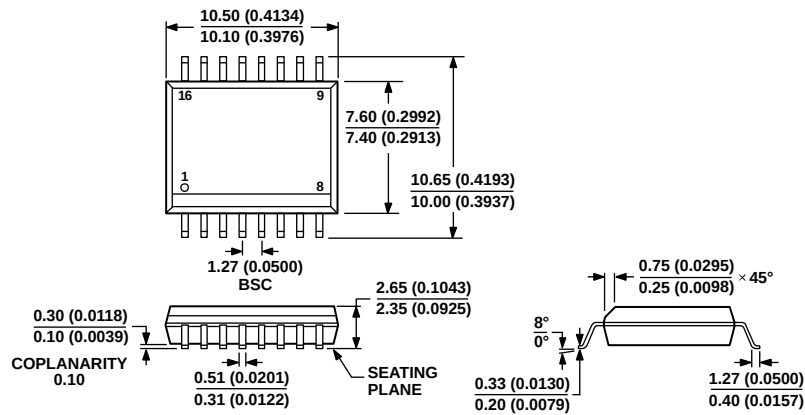
图27. 16引脚标准小型封装[SOIC_N]

窄体

(R-16)

图示尺寸单位: mm和(inch)

060606-A



COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-013-AA
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.

图28. 16引脚标准小型封装[SOIC_W]

宽体

(RW-16)

图示尺寸单位: mm和(inch)

03-27-2007-B

ADuM3223/ADuM4223

订购指南

型号 ^{1,2}	通道数	输出峰值电流 (A)	最小输出 电压(V)	温度范围	封装描述	封装选项	订购数量
ADuM3223ARZ	2	4	4.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_N	R-16	1,000
ADuM3223ARZ-RL7	2	4	4.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_N, 7"卷带和卷盘	R-16	
ADuM3223BRZ	2	4	7.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_N	R-16	
ADuM3223BRZ-RL7	2	4	7.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_N, 7"卷带和卷盘	R-16	1,000
ADuM3223CRZ	2	4	11.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_N	R-16	1,000
ADuM3223CRZ-RL7	2	4	11.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_N, 7"卷带和卷盘	R-16	
ADuM3223WARZ	2	4	4.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_N	R-16	
ADuM3223WARZ-RL7	2	4	4.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_N, 7"卷带和卷盘	R-16	1,000
ADuM3223WBRZ	2	4	7.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_N	R-16	1,000
ADuM3223WBRZ-RL7	2	4	7.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_N, 7"卷带和卷盘	R-16	
ADuM3223WCRZ	2	4	11.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_N	R-16	
ADuM3223WCRZ-RL7	2	4	11.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_N, 7"卷带和卷盘	R-16	1,000
ADuM4223ARWZ	2	4	4.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_W	RW-16	1,000
ADuM4223ARWZ-RL	2	4	4.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_W, 13"卷带和卷盘	RW-16	
ADuM4223BRWZ	2	4	7.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_W	RW-16	
ADuM4223BRWZ-RL	2	4	7.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_W, 13"卷带和卷盘	RW-16	1,000
ADuM4223CRWZ	2	4	11.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_W	RW-16	1,000
ADuM4223CRWZ-RL	2	4	11.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_W, 13"卷带和卷盘	RW-16	
ADuM4223WARWZ	2	4	4.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_W	RW-16	
ADuM4223WARWZ-RL	2	4	4.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_W, 13"卷带和卷盘	RW-16	1000
ADuM4223WBRWZ	2	4	7.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_W	RW-16	1000
ADuM4223WBRWZ-RL	2	4	7.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_W, 13"卷带和卷盘	RW-16	1000
ADuM4223WCRWZ	2	4	11.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_W	RW-16	1000
ADuM4223WCRWZ-RL	2	4	11.5	−40°C至+125°C	16引脚 SOIC_W, 13"卷带和卷盘	RW-16	1000
EVAL-ADuM3223AEBZ	2	4	4.5	−40°C至+125°C	ADuM3223评估板		
EVAL-ADuM4223AEBZ	2	4	4.5	−40°C至+125°C	ADuM3223评估板		

¹ Z = 符合RoHS标准的器件。

² ADuM3223W和ADuM4223W = 通过汽车应用认证。

汽车应用产品

ADuM3223W和ADuM4223W生产工艺受到严格控制，以提供满足汽车应用的质量和可靠性要求。请注意，车用型号的技术规格可能不同于商用型号；因此，设计人员应仔细阅读本数据手册的技术规格部分。只有显示为汽车应用级的产品才能用于汽车应用。欲了解特定产品的订购信息并获得这些型号的汽车可靠性报告，请联系当地ADI客户代表。